05,06

Электронная структура и несобственная электрическая поляризация ортоферрита самария

© В.В. Тригук 1 , И.И. Макоед 1,¶ , А.Ф. Ревинский 2

(Поступила в Редакцию 28 апреля 2016 г.)

Из первых принципов методом функционала плотности в рамках приближения LSDA + U рассчитаны зонная структура, распределения электронной и спиновой плотностей ортоферрита самария с учетом коллинеарного антиферромагнитного упорядочения магнитных моментов катионов железа и самария. На основании результатов теоретико-группового анализа рассмотрена возможность индуцирования сегнетоэлектрического состояния при температурах, меньших точки антиферромагнитного упорядочения магнитной подрешетки, образованной катионами самария. В области высоких температур возникновение областей со спонтанной электрической поляризацией возможно при наличии дополнительных факторов, понижающих симметрию кристалла.

Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований на 2016—2020 гг. "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии".

1. Введение

Феррит самария SmFeO₃ (SFO) относится к семейству редкоземельных ортоферритов с перовскитоподобной кристаллической структурой (пр. гр. D_{2h}^{16} — Pbnm) [1]. В последнее время данный материал привлекает внимание исследователей в связи с обнаружением в нем несобственной сегнетоэлектрической поляризации $(T_C=670\,\mathrm{K})$: $P_s=100\,\mu\mathrm{C/m^2}$ [2]. Ранее было установлено [3,4], что в SFO реализуется антиферромагнитное (АФМ) упорядочение G-типа спинов катионов железа Fe^{3+} при температурах, меньших $T_{N1} = 670 \, \text{K}$. В работах [2,5,6] описан обнаруженный в образцах SFO слабый ферромагнетизм, обусловленный нарушением коллинеарности (скосом) спиновых моментов подрешеток, образованных магнитоактивными катионами Fe³⁺ (d-подрешетка) и Sm^{3+} (f-подрешетка). При низких температурах $T < T_{N2} = 10 \, \mathrm{K}$ спины катионов самария также образуют АФМ-порядок [3], как это показано на рис. 1. Совпадение точек Кюри и Нееля $(T_C = T_{N1})$ дает основание отнести данное соединение к мультиферроикам второго рода, в которых сегнетоэлектрическая (СЭ) фаза индуцируется магнитоэлектрическим (МЭ) взаимодействием [7].

Сложный характер температурно-обусловленной спиновой динамики магнитоактивных катионов приводит к наличию в SFO ряда фазовых превращений. В частности, при температуре $T_{\rm SR}=480~{\rm K}$ происходит спин-переориентационный переход, в результате которого изменяется магнитная симметрия d-подрешетки: $\Gamma_2(F_x^dC_y^dG_z^d) \to \Gamma_4(G_x^dA_y^dF_z^d)$ [2,5,6]. При температуре компенсации $(T^*=5~{\rm K})$ наблюдается изменение знака намагниченности SFO на противоположный [2,5]. Это

открывает перспективы для возможного использования ортоферрита самария в качестве материала для создания высокоскоростных переключателей [5] и многопараметрических устройств спинтроники [8].

Теория магнитной симметрии d- и f-подсистем в ортоферритах хорошо разработана. Пространственная группа Pbnm является центрально-симметричной (включает операцию инверсии). Магнитная элементарная ячейка совпадает с кристаллической. Относительно природы несобственной электрической поляризации и магнитоэлектрических взаимодействий в d- и f-подрешетках SFO в литературе приведены противоречивые данные [2,9]. В связи с этим представляет интерес проведение ab initio расчетов распределения электронной и спиновой плотности, а также теоретико-групповой анализ возможных упорядоченных магнитных и зарядовых состояний в SFO с целью выяснения причин сосуществования СЭ- и $A\Phi M$ -фаз.

Целью настоящей работы является теоретическое исследование условий совместимости антиферромагнитного упорядочения и сегнетоэлектрической поляризации в $SmFeO_3$ на основании данных *ab initio* расчетов зонной структуры, распределения спиновой плотности и результатов теоретико-группового анализа.

2. Расчет зонной структуры

Для выполнения теоретических расчетов зонной структуры использовался метод функционала электронной плотности, реализованный в программном комплексе ABINIT [10]. Соединения с частично заполненными внутренними d- и f-оболочками являются веществами с

5* 2355

¹ Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брест, Беларусь

² Белостокский технический университет, Белосток, Польша

E-mail: igmak2010@yandex.ru

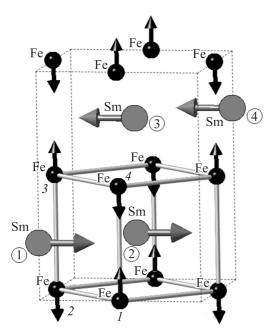


Рис. 1. Магнитная структура $SmFeO_3$. Цифры соответствуют атомам Fe, цифры в кружках — атомам Sm.

сильнокоррелированной электронной подсистемой. Поэтому при расчетах для обменно-корреляционного взаимодействия было использовано приближение LSDA + U (LSDA — local spin density approximation) в гамильтониане Кона–Шема [11]. Расчеты проводились для однородных коллинеарных АФМ-упорядочений G-типа (d-подрешетка) и C-типа (f-подрешетка).

Как было показано в работе [6], теоретические значения параметров кристаллической решетки ортоферритов слабо зависят от типа магнитной симметрии. Оптимизацию кристаллической структуры проводили, интегрируя в зоне Бриллюэна по схеме $5\times 5\times 5$ до достижения величин сил Гельмана—Феймана, равных 10^{-6} Ha/Bohr. Максимальная кинетическая энергия плоских волн задавалась равной 25 Ha. В качестве валентных учитывалось шестнадцать электронов для Sm $(4f^55s^25p^65d^1s^2)$, восемь для Fe $(3d^64s^2)$ и шесть для O $(2s^22p^4)$. Параметры корреляционного взаимодействия задавались равными

Равновесные значения координат позиций Уайкова и параметров решетки ${\rm SmFeO_3}$

Параметр	Данные настоящей работы			Данные [14]		
Fe^{3+} (4 <i>b</i>)	0.5	0	0	0.5	0	0
$Sm^{3+} (4c)$	0.4985	0.5038	0.25	0.5134	0.5572	0.25
O_1^{2-} (4c)	0.5014	1.0044	0.25	0.3958	0.9894	0.25
O_2^{2-} (8d)	0.2247	0.7168	0.9999	0.2862	0.6966	0.9613
a, Å		5.3979			5.4026	
$b, \mathrm{\AA}$		5.6480			5.6001	
c, Å		7.6574			7.7129	

 $U_{\rm eff}=4\,{\rm eV}$ для 3d-электронов железа и $U_{\rm eff}=6\,{\rm eV}$ для 4f- и 5d-электронов самария. Как показали результаты более ранних расчетов, при указанных значениях $U_{\rm eff}$ происходит относительная стабилизация зонной структуры [12,13].

В таблице представлены вычисленные значения параметров решетки SFO в сравнении с известными экспериментальными данными. Для оптимизации параметров кристаллической решетки была использована коллинеарная магнитная структура, изображенная на рис. 1. Результаты расчетов показывают, что минимальному значению полной энергии соответствуют следующие магнитные моменты: $\mu(\mathrm{Fe^{3+}}) = (0, 0, 3.68)\mu_{\mathrm{B}}$ и $\mu(\mathrm{Sm^{3+}}) = (0, 5.40, 0)\mu_{\mathrm{B}}$. Величина магнитного момента, рассчитанная для катиона $\mathrm{Fe^{3+}}$, близка к значению, полученному в работе [15]. Распределение разностной спиновой плотности $\Delta \rho = \rho \uparrow - \rho \downarrow$ указывает на тенденцию к противоположной ориентации магнитных моментов катионов d- и f-подсистем.

Рассчитанные зонные структуры SFO для различных направлений спинов валентных электронов (spin up и spin down) представлены на рис. 2, 3. Как следует из результатов расчетов полной электронной плотности, приведенных на рис. 4, a, ортоферрит самария является полупроводником с шириной запрещенной зоны $E_g=2.0\,\mathrm{eV}$. Полученная величина хорошо согласуется с расчетными данными работы [16]. Зона проводимости

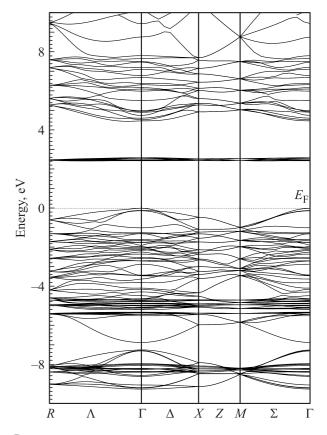


Рис. 2. Зонная структура SmFeO₃ для состояний spin up.

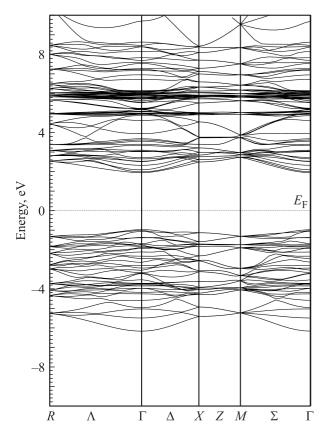


Рис. 3. Зонная структура SmFeO₃ для состояний spin down.

SFO сформирована в основном spin up состояниями и является своеобразным "фильтром" для электронов с определенной ориентацией спинового магнитного момента. Анализ распределения парциальных плотностей электронных состояний свидетельствует о том, что данная особенность в формировании зоны проводимости в значительной мере обусловлена 3d-состояниями железа, показанными на рис. 4, c. Энергетические уровни сильнокоррелированных 3d-состояний железа и 4f-состояний самария, представленных на рис. 4, b, локализованы в значительной степени в валентной зоне с положительным (spin up) направлением спина.

Величина вклада 3d-электронов катионов железа в полную плотность состояний вблизи уровня Ферми составляет примерно 20%. Дно зоны проводимости сформировано 3d-состояниями катионов железа с отрицательным (spin down) направлением спина и 4f-состояниями катионов самария с положительным (spin up) направлением спина. Потолок валентной зоны, как видно на рис. 4,d, представлен, в основном, 2s-и 2p-состояниями электронов кислорода. Полученная картина распределения электронных состояний SFO является типичной для ортоферритов $GdFeO_3$, $TbFeO_3$, $EuFeO_3$, pesyльтаты расчета зонных структур которых приведены в работе <math>[17].

Слабый ферромагнетизм SFO обусловлен скосом магнитных подрешеток катионов Fe^{3+} и Sm^{3+} . Как видно

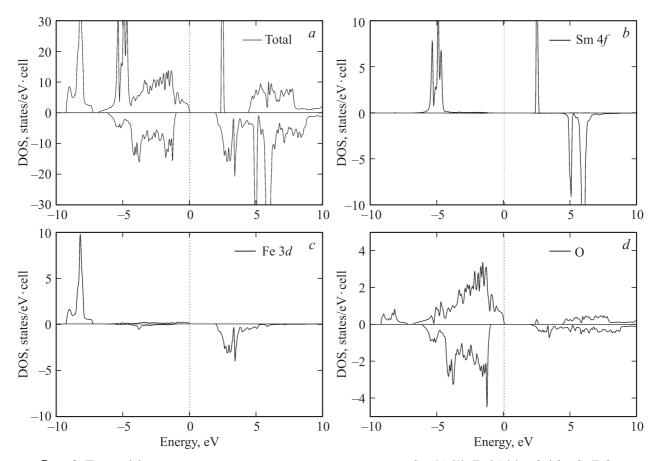


Рис. 4. Полная (a) и парциальные плотности электронных состояний Sm 4f (b), Fe 3d (c) и O (d) в SmFeO₃.

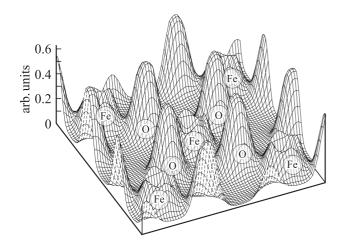


Рис. 5. Распределение электронной плотности в d-плоскости SmFeO₃.

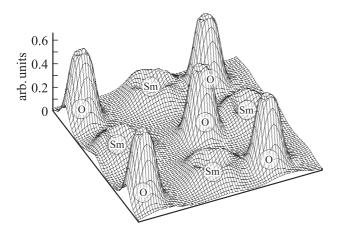


Рис. 6. Распределение электронной плотности в f-плоскости SmFeO₃.

из рис. 5 и 6, между катионами железа и самария наблюдается высокая плотность валентных электронов лигандов O^{2-} , которые занимают положения Уайкова 4c и 8d. Полученные результаты свидетельствуют о преобладающей роли косвенных обменных взаимодействий $\mathrm{Fe^{3+}}\mathrm{-O^{2-}}\mathrm{-Fe^{3+}}$ и $\mathrm{Sm^{3+}}\mathrm{-O^{2-}}\mathrm{-Sm^{3+}}$ над прямыми взаимодействиями $\mathrm{Fe^{3+}}\mathrm{-Fe^{3+}}$, $\mathrm{Sm^{3+}}\mathrm{-Sm^{3+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}\mathrm{-Sm^{3+}}$.

3. Магнитоэлектрическое взаимодействие в SFO

Необходимым условием сосуществования магнитного упорядочения и СЭ-поляризации в кристалле является нарушение пространственной и временной инверсии [7]. В ортоферрите самария *d*-подрешетка является центрально-симметричной, а следовательно, неактивной в плане МЭ-взаимодействия и сосуществования АФМ- и СЭ-упорядочений. Центрально-асимметричная

f-подрешетка допускает наличие сегнетоэлектрической поляризации в отсутствие внешних электрического и магнитного полей. Представленные на рис. 6 данные подтверждают асимметричный характер распределения электронной плотности SFO в f-плоскости и указывают на возможность установления упорядоченного состояния со спонтанной электрической поляризацией \mathbf{P}_s .

Теоретические основы магнитных структур ортоферритов в настоящее время достаточно хорошо разработаны [3,18,19]. Слабый ферромагнетизм SFO обусловлен нарушением коллинеарности спиновых магнитных моментов \mathbf{S}_i^d катионов \mathbf{Fe}^{3+} и \mathbf{S}_i^f катионов \mathbf{Sm}^{3+} [5,18]. Согласно результатам нейтронографических исследований, изложенным в работах [2,5,6], магнитная структура d-подрешетки SFO при $T_{\mathrm{SR}} < T < T_{N1}$ характеризуется симметрией $\Gamma_4(G_x^d A_y^d F_z^d)$, а при $T < T_{\mathrm{SR}}$ симметрией $\Gamma_2(F_x^d C_y^d G_z^d)$ (рис. T_2 , T_2). При низких температурах $T_{N2} < 10\,\mathrm{K}$ в кристалле формируется дополнительный вклад, обусловленный слабым прямым обменным вза-имодействием $\mathrm{Sm}^{3+} - \mathrm{Sm}^{3+}$. В результате в SFO устанавливается АФМ-тип магнитного упорядочения в обеих магнитных подрешетках.

Неколлинеарные векторы $\Gamma_2(F_x^d C_y^d G_z^d)$ в общем случае имеют следующие компоненты: $\mathbf{S}_1^d = (-u, v, w), \ \mathbf{S}_2^d = (-u, v, -w), \ \mathbf{S}_3^d =$ $=(-u,-v,-w), \mathbf{S}_4^d=(-u,-v,w),$ где u,v,wдекартовы компоненты в единицах $\mu_{\rm B}$. Такая структура соответствует магнитному упорядочению G-типа вдоль оси z. Намагниченность обусловлена нарушением коллинеарности $(u \neq 0, v \neq 0)$ и равна $M^d = -4u$ Направление вектора $\mathbf{M}^d = (-4u, 0, 0)$ $(\mu_{\rm B}/{\rm cell})$. противоположно направлению оси х. Магнитная структура ионов Sm³⁺ (f-подсистема) $\Gamma_2(F_x^f C_v^f)$ соответствует антиферромагнитному упорядочению С-типа вдоль оси у и может быть задана вектором $\mathbf{M}^f = (2(p-p'), 0, 0)$ с компонентами $\mathbf{S}_1^f = (p, q, 0),$ $\mathbf{S}_2^f=(p,-q,0),\ \mathbf{S}_3^f=(p,-q,0),\ \mathbf{S}_4^f=(p,q,0).$ Нарушение коллинеарности $(p\neq 0)$ обусловливает намагниченность $M^f=4p~(\mu_{
m B}/{
m cell}),$ направленную противоположно вектору \mathbf{M}^d . Результирующая намагниченность определяется выражением $\mathbf{M} = \mathbf{M}^d - \mathbf{M}^f$, которое позволяет объяснить в рамках двухподрешеточной модели экспериментально наблюдаемые особенности температурной зависимости величины удельной намагниченности. Согласно законам симметрии представление $\Gamma_2(F_x^d C_y^d G_z^d)$, для d-подрешетки совместимо с изображенным на рис. 7, cпредставлением $\Gamma_2(F_x^fC_y^f)$ f-подрешетки [3]. Тогда полученному представлению $\Gamma_2(F^d_xC^d_yG^d_z;F^f_xC^f_y)$ соответствует точечная магнитная группа тт [9,18], которая является неполярной; следовательно, наблюдаемая экспериментально спонтанная СЭ-поляризация SFO не может быть индуцирована за счет МЭ-взаимодействия.

МЭ-активную спиновую конфигурацию $\Gamma_{25}(F_x^fC_y^f;G_x^fA_y^f)$ для f-подрешетки SFO, приведенную на рис. 7, d, можно получить при помощи комбинации представлений $\Gamma_2(F_x^fC_y^f)$ и $\Gamma_5(G_x^fA_y^f)$. Спиновой конфи-

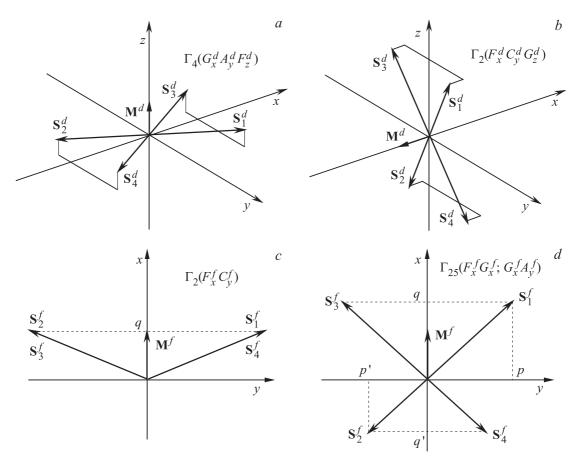


Рис. 7. Магнитные конфигурации d- (a,b) и f-подрешеток (c,d) SmFeO₃.

гурации $\Gamma_{25}(F_x^dC_y^dG_z^d,F_x^fC_y^f;G_x^fA_y^f)$ при низких $(T < T_{N2})$ температурах соответствует магнитная точечная группа mm'2, которая является полярной [18]. Компоненты магнитных моментов \mathbf{S}_i^f ионов Sm^{3+} для полученного представления Γ_{25} имеют вид $\mathbf{S}_1^f = (p,q,0),~\mathbf{S}_2^f = (-p',q,0),~\mathbf{S}_3^f = (p,-q,0),~\mathbf{S}_4^f = (-p',-q',0).$ Результирующий магнитный момент подрешетки катионов самария равен $\mathbf{M}^f = (2(p-p'),0,0).$ При этом намагниченности d- и f-подрешеток противоположны и направлены вдоль оси x.

Данная модель позволяет объяснить наличие температуры компенсации, при которой $\mathbf{M}^f = -\mathbf{M}^d$, а также допускает возможность индуцирования в результате МЭ-взаимодействия, т.е. без влияния внешних электрического или магнитного полей, спонтанной СЭ-поляризации $\mathbf{P}_s = (0, p_y, 0)$, экспериментально наблюдаемой при $T < T_{N2}$ [2]. С ростом температуры при $T > T_{N2}$ АФМ-упорядочение магнитных моментов катионов Sm^{3+} разрушается, и f-подрешетка переходит в парамагнитное состояние. При этом d-подрешетка продолжает сохранять две магнитные конфигурации $\Gamma_2(F_x^d C_y^d G_z^d)$ при $T < T_{\mathrm{SR}}$ и $\Gamma_4(G_x^d A_y^d F_z^d)$ при $T_{\mathrm{SR}} < T < T_{N2}$, оставаясь центрально-симметричной. В области высоких температур спонтанная СЭ-поляризация запрещена законами симметрии, и для объяснения

ее наличия следует признать возможным существование в SFO дополнительных факторов, понижающих симметрию кристалла. В качестве последних могут выступать как магнитоупругие взаимодействия, так и локальные понижения симметрии за счет возникновения фрустрированной магнитной структуры.

4. Заключение

Результаты *ab initio* расчетов зонной структуры показывают, что в основном состоянии ортоферрит самария является полупроводником с шириной запрещенной зоны 2 eV. Определяющая роль в формировании энергетических полос вблизи уровня Ферми принадлежит сильнокоррелированным 3d-состояниям электронов катионов железа и f-состояниям электронов катионов самария. Топография карт распределения электронной плотности указывает на наличие выраженной ее асимметрии в f-подрешетке и служит основанием для связи несобственной спонтанной СЭ-поляризации в области низких температур с магнитоэлектрическим взаимодействием. При этом спиновая конфигурация должна соответствовать представлению $\Gamma_{25}(F_x^d C_y^d G_z^d; F_x^f C_y^f; G_x^f A_y^f)$ магнитной симметрии d- и f-подрешеток.

Список литературы

- [1] А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 296 с.
- [2] J.-H. Lee, Y.K. Jeong, J.H. Park, M.-A. Oak, H.M. Jang, J.Y. Son, J.F. Scott. Phys. Rev. Lett. 107, 117201 (2011).
- [3] R.L. White. J. Appl. Phys. 40, 3, 1061 (1969).
- [4] E.N. Maslen, V.A. Streltsov, N. Ishizawa. Acta Cryst. B 52, 406 (1996).
- [5] Y.K. Jeong, J.-H. Lee, S.-J. Ahn, H.M. Jang. Solid State Commun. 152, 1112 (2012).
- [6] L.G. Marshall, J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, J.B. Goodenough, J.-Q. Yan, D.G. Mandrus. Phys. Rev. B 86, 064417 (2012).
- [7] А.К. Звездин, А.П. Пятаков. УФН 182, 6, 594 (2012).
- [8] X. Wang, X. Cheng, S. Gao, J. Song, K. Ruan, X. Li. J. Magn. Magn. Mater. 399, 170 (2016).
- [9] R.D. Johnson, N. Terada, P.G. Radaelli. Phys. Rev. Lett. 108, 219701 (2012).
- [10] X. Gonze, G.M. Rignanese, M. Verstraete, J.M. Beuken, Y. Pouillon, R. Caracas, F. Jollet, M. Torrent, G. Zerah, M. Mikami, P. Ghosez, M. Veithen, J.Y. Raty, V. Olevano, F. Bruneval, L. Reining, R. Godby, G. Onida, D.R. Hamann, D.C. Allan. Comp. Phys. Commun. 220, 558 (2005).
- [11] S.L. Dudarev, L.-M. Peng, S.Y. Savrasov, J.-M. Zuo. Phys. Rev. B 61, 2506 (2000).
- [12] А.Ф. Ревинский, В.В. Тригук, И.И. Макоед. ФТТ **56**, *9*, 1739 (2014).
- [13] L. Chen, T. Li, S. Cao, S. Yuan, F. Hong, J. Zhang. J. Appl. Phys. 111, 103905 (2012).
- [14] N.N. Li, H. Li, R.-L. Tang, D.-D. Han, Y.-S. Zhao, W. Gao, P.-W. Zhu, X. Wang. Chin. Phys. 23, 046105 (2014).
- [15] В.С. Жандун, В.И. Зиненко. ФТТ 57, 5, 970 (2015).
- [16] N. Singh, J.Yu. Rhee, S. Auluck. J. Korean Phys. Soc. 53, 2, 806 (2008).
- [17] D. Mekam, S. Kacimi, M. Djermouni, M. Azzouz, A. Zaoui. Results Phys. 2, 156 (2012).
- [18] T. Yamaguchi, K. Tsushima. Phys. Rev. B 8, 11, 5187 (1973).
- [19] А.К. Звездин, А.А. Мухин. Письма в ЖЭТФ **88**, *8*, 581 (2008).